УДК 532.6:541.8 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ К ИССЛЕДОВАНИЮ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНДЕНСИРОВАННЫХ ПЛЕНОК

И.В. Гринев, В.В. Зубков, В.М. Самсонов Тверской государственный университет, 170002, Тверь, Садовый пер., 35, samsonoff@inbox.ru

На основе метода функционала плотности проведены расчеты распределения плотности в равновесных леннард-джонсовских пленках. Расчеты проведены как для очень тонких адсорбционных слоев, так и для смачивающих слоев. Установлено, что профили плотности характеризуются наличием выраженных максимумов, которые свидетельствуют о высокой степени позиционной упорядоченности молекул в слое.

Обычно к методам функционала плотности (МФП) относят подходы позволяющие находить распределение плотности электронного газа в макроскопических телах и низкоразмерных системах на основе решения функционального интегрального уравнения для электронной плотности. Данная работа связана с развитием аналогичного в методологическом плане подхода, направленного, однако, на нахождение локальной молекул плотности числа (атомов) исследуемой В системе. Соответственно, следуя нашей работе [1], мы называем этот вариант МФП методом функционала атомной плотности (МФАП). В этом случае используются обычные соотношения статистической термодинамики применительно к неоднородным системам, вследствие чего, локальная плотность будет фигурировать под знаком интеграла. Разумеется, при переходе от объемных фаз к граничным слоям и низкоразмерным системам, т.е. к существенно неоднородным системам, трудности применения МФАП в значительной степени возрастают. Вместе с тем, в последние годы МФАП является одним из наиболее популярных методов изучения неоднородных систем [2-5].

Суть МФАП сводится к тому, что возможно полное и точное описание основного состояния системы через ее локальную плотность $\rho(\mathbf{r})$. Соответственно, большой потенциал $\Omega(\rho)$ системы или энергия Гельмгольца $F(\rho)$ рассматривается как функционал локальной плотности. Затем его варьированием находят основное уравнение для определения плотности основного равновесного состояния системы. При этом возможны различные приближения МФАП, связанные с тем или иным выбором выражения для энергии Гельмгольца (и, как следствие, для большого потенциала). Среди различных вариантов можно отметить МФАП в локальном приближении, в рамках которого получается интегральное уравнение, применяемое для описания слабо неоднородных

22

систем (например, «капля-пар»), и МФАП в приближении с весовыми множителями [3,4], приводящие к более сложным интегральным уравнениям, которые применимы для сильно неоднородных систем (например, слоям жидкости на подложке). Среди последних подходов, наиболее точно описывающих экспериментальные данные, является модифицированный метод Розенфельда, предложенный Янгом Ксин Ю и Джансхонг Ву [6]. Интегральное уравнение, полученное в рамках этого подхода, имеет следующий вид:

$$\ln\left(\Lambda^{3}\rho(\mathbf{r})\right) + U_{ext}\left(\mathbf{r}\right) + \frac{1}{k_{B}T}\frac{\delta F_{r,ex}}{\delta\rho} + \int_{V} d^{3}\mathbf{r}'\rho(\mathbf{r}')U_{att}\left(\left|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right|\right) = \mu.$$
(1)

Здесь μ – химический потенциал системы, $U_{ext}(\mathbf{r})$ – потенциал внешнего поля, $F_{r,ex}$ – свободная энергия, связанная с системой жестких сфер, выраженная в терминах весовых плотностей [6], U_{att} – потенциал сил притяжения, Λ – длина волны де-Бройля.

Вариант МФАП с весовыми множителями позволяет исследовать поведение плотности в адсорбционных и смачивающих слоях на поверхности твердого адсорбента. Ранее [1] в качестве адсорбционного потенциала твердой поверхности использовался одночастичный потенциал

$$U(z) = \frac{2}{3}\pi\varepsilon_f \sqrt{\frac{\varepsilon_s}{\varepsilon_f}} \left\{ \frac{2}{15} \left(\frac{\sigma_s}{\sigma_f} \right)^3 \left(\frac{\sigma_f}{z} \right)^9 - \left(\frac{\sigma_f}{z} \right)^3 \right\},$$
(2)

полученный одним из авторов [7] интегрированием потенциала Леннард– Джонса по полупространству, занимаемому подложкой. Здесь z – координата, отвечающая направлению перпендикулярному поверхности подложки (z = 0 отвечает поверхности адсорбента). ε_s , ε_f –энергетические параметры парного потенциала для веществ, отвечающих подложке (адсорбенту) и пленке (адсорбату) соответственно. σ_s , σ_f –эффективные диаметры молекул подложки и пленки соответственно. При записи (2) было положено, что приведенная плотность числа молекул в подложке равны единице ($\rho_s^* = \rho_s \sigma_s^3$). Это допущение вполне адекватно, поскольку приведенная плотность леннард-джонсовского флюида при температуре плавления равна 0.9, а приведенная плотность соответствующего кристалла равна 1.1 - 1.2. Следует также отметить, что при выводе (2) вместо обычно рекомендуемого соотношения [8]

$$\sigma_{sf} = \left(\sigma_s + \sigma_f\right)/2 \tag{3}$$

использовалась в целях упрощения конечного выражения, среднее геометрическое

$$\sigma_{sf} = \sqrt{\sigma_s \sigma_f} \,. \tag{4}$$

Однако к настоящему времени мы убедились в том, что при заметном различии между σ_s и σ_f (в 1.5-2 раза) среднее арифметическое и среднее геометрическое могут существенно различаться. В связи с этим, в данной работе вместо выражения (4) использовалось соотношение (3). Тогда вместо потенциала (2) получим следующий одночастичный потенциал

$$U(z) = \frac{\pi}{3 \cdot 2^5} \varepsilon_f \sqrt{\frac{\varepsilon_s}{\varepsilon_f}} \rho_s \sigma_s^3 \left(\frac{\sigma_f}{\sigma_s}\right)^3 \left(\frac{\sigma_s}{\sigma_f} + 1\right)^6 \left[\frac{1}{15 \cdot 2^5} \left(\frac{\sigma_s}{\sigma_f} + 1\right)^6 \left(\frac{\sigma_f}{z}\right)^9 - \left(\frac{\sigma_f}{z}\right)^3\right].$$
(5)

Переходя к приведенным величинам $z^* = z/\sigma_f$, $U^*(z^*) = U(z^*)/kT$, и полагая $\rho_s \sigma_s^3 \simeq 1$, получим

$$U^{*}\left(z^{*}\right) = \frac{\pi}{3 \cdot 2^{5}} \frac{\varepsilon_{f}}{kT} \sqrt{\frac{\varepsilon_{s}}{\varepsilon_{f}}} \frac{\sigma_{f}^{3}}{\sigma_{s}^{3}} \left(\frac{\sigma_{s}}{\sigma_{f}} + 1\right)^{6} \left[\frac{1}{15 \cdot 2^{5}} \left(\frac{\sigma_{s}}{\sigma_{f}} + 1\right)^{6} \frac{1}{z^{*9}} - \frac{1}{z^{*3}}\right].$$
 (6)

В дальнейшем в качестве параметра приведения будет также использоваться диаметр жесткой сферы d. Еще раз переопределяя координаты $(z/\sigma_f = (z/d)/(\sigma_f/d) = z^{**}/(\sigma_f/d))$, окончательно получим

$$U^{*}\left(z^{**}\right) = \frac{\pi}{3 \cdot 2^{5}} \frac{\varepsilon_{f}}{kT} \sqrt{\frac{\varepsilon_{s}}{\varepsilon_{f}}} \frac{\sigma_{f}^{3}}{\sigma_{s}^{3}} \left(\frac{\sigma_{s}}{\sigma_{f}} + 1\right)^{6} \left[\frac{1}{15 \cdot 2^{5}} \left(\frac{\sigma_{s}}{\sigma_{f}} + 1\right)^{6} \frac{\left(\sigma_{f}/d\right)^{9}}{z^{**9}} - \frac{\left(\sigma_{f}/d\right)^{3}}{z^{**3}}\right].$$
(7)

Данный потенциал позволяет изучить влияние характерных размеров атомов и их энергетических параметров на значения плотности в адсорбционном слое, а также определить, сколько монослоев может образоваться при заданных условиях. Ранее авторами статьи [9] был рассчитаны профили плотности в смачивающем слое с использованием потенциала, предложенного в работе [10] и имеющего следующий вид:

$$U(z) = \frac{12}{d^3} \varepsilon_f \sigma_f^3 \left\{ 5.326 \left(\frac{\sigma_f}{z}\right)^9 - 2.348 \left(\frac{\sigma_f}{z}\right)^3 \right\}.$$
 (8)

Данный потенциал, в отличие от потенциала (7), не позволяет оценить влияние параметров подложки на характеристики смачивающих и адсорбционных слоев.

Используя МФАП и потенциал (7) мы рассчитали распределения плотности в адсорбате. На структуру адсорбционного слоя заметное влияние оказывают относительные параметры потенциала подложки: приведенный энергетический параметр $\varepsilon_s^* = \varepsilon_s / \varepsilon_f$ и линейный параметр $\sigma_s^* = \sigma_s / \sigma_f$. Помимо параметров потенциалов в качестве управляющих параметров использовались относительное давление $s = p/p_s$ (p_s давление насыщенного пара) и значение приведенной температуры $\tau = T/T_c$ (T_c – критическая температура). В результате вычислений было

24

установлено, что сформированные на поверхности тонкие адсорбционные пленки характеризуются высокой степенью упорядоченности (см. рис. 1).



Рис. 1. Распределение приведенной плотности числа молекул $\eta = \pi d^3 \rho / 6$ по приведенной координате $z^{**} = z/d$ (ось z перпендикулярна подложке), $\varepsilon_s^* = 72,3$, $\sigma_s^* = 2,2$, $\tau = 0,75:1$) s = 0,39,2) s = 0,59,3) s = 0,65,4) s = 0,72,5) s = 0,92



Рис. 2. Распределение приведенной плотности числа молекул $\eta = \pi d^3 \rho / 6$ по приведенной координате $z^{**} = z/d$, $\tau = 0.85$, s = 0.7, $\sigma_s^* = 1$: 1) $\varepsilon_s^* = 30$, 2) $\varepsilon_s^* = 10$, 3) $\varepsilon_s^* = 5$, 4) $\varepsilon_s^* = 3$, 5) $\varepsilon_s^* = 2$



Рис. 3. Распределение приведенной плотности числа молекул $\eta = \pi d^3 \rho / 6$ по приведенной координате $z^{**} = z/d$, $\tau = 0,75$, s = 0,83, $\mathcal{E}_s^* = 1:1$) $\sigma_s^* = 0,83, 2$) $\sigma_s^* = 0,85, 3$) $\sigma_s^* = 0,9,4$) $\sigma_s^* = 0,95, 5$) $\sigma_s^* = 1$



Рис. 4. Распределение приведенной плотности числа молекул $\eta = \pi d^3 \rho / 6$ по приведенной координате $z^{**} = z/d$, $\tau = 0, 6$, s = 1

Иными словами, пленка имеет выраженную слоистую структуру, которая проявляется в резких пиках локальной плотности. Примечательно также, что при значении *s*, близком к единице, на твердой поверхности формируется пристенный полимолекулярный слой (смачивающий слой), для которого асимптотическое значение приведенной плотности равно 0.4.

Это значение близко к плотности массивной фазы леннард-джонсовского флюида при температурах, близких к температуре плавления. На рис. 2 и 3 представлены профили локальной плотности, отвечающие различным значениям относительного энергетического параметра подложки и относительного диаметра молекул подложки. Как видно из рис. 2, увеличение энергетического параметра адсорбента приводит к появлению второго пика на профиле плотности, т.е., как и следовало ожидать, способствует адсорбции. Аналогичный, но менее выраженный эффект дает уменьшение размера молекул подложки.

На рис. 4 представлены результаты, полученные с использованием потенциала (9) с фиксированными значениями параметров, который ранее применялся в работе [5]. Видно, что при правильном выборе соответствующих параметров нашего, более общего, потенциала результаты (кривая 5 на рис. 1 и рис. 4) хорошо согласуются друг с другом.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 07-03-00243-а и № 08-03-97511р_центр_а).

Библиографический список

1. *Самсонов, В.М.* Квазитермодинамический подход к проблеме стабильности смачивающих слоев неполярных жидкостей / В.М. Самсонов, В.В. Зубков // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 2007. – № 5. – С. 103-108.

2. *Evans, R.* Density functionals in the theory of nonuniform liquids, in Fundamentals of inhomogeneous fluids Ed. D. Henderson / R. Evans. – New York: M. Dekker, 1992. – P. 85-175.

3. *Tarazona, P.* Free-energy density functional for hard spheres / P. Tarazona // Physical Review A. – 1985. – V. 31. – N. 4. – P. 2672-2679.

4. *Denton, A.R.* Modified weighted-density-functional theory of nonuniform classical liquids / A.R. Denton, N.W. Ashcroft // Physical Review A. – 1989. – V. 39. – N. 9. – P. 4701-4708. 5. *Быков, Т.В.* Термодинамические характеристики малой капли в рамках метода функционала плотности / Т.В. Быков, А.К. Щекин // Коллоидный журнал. – 1999. – Т. 61, – № 2. – С. 164-171.

6. *Yu*, *Y.-X.* Structures of hard-sphere fluids from a modified fundamental-measure theory / Y.-X. Yu, J. Wu // Journal of Chemical Physics. – 2002. – V. 117. – N. 22. – P. 10156-10164. 7. *Самсонов, В.М.* Моделирование по методу Монте-Карло процесса растекания нанометровых капель жидкостей по поверхности твердого тела / В.М. Самсонов, С.Д. Муравьев, П.Г. Халатур // Коллоидный журнал. – 1998. – Т. 60. – №3. – С. 401-408.

8. *Киттель, Ч.* Введение в физику твердого тела / Ч. Киттель. – М.: Наука, 1978. – 792 с.

9. *Bykov, T.V.* Heterogeneous nucleation on mesoscopic wettable particles: A hybrid thermodynamic/density-functional theory / T.V. Bykov, X.C. Zeng // Journal of Chemical Physics. – V. 117. – N. 4. – P. 1854-1868.

10. *Getta, T.* Line tension between fluid phases and a substrate / T. Getta, S. Dietrich // Physical Review E. – 1985. – V. 57. – N. 1. – P. 655-670.